

# 2SA755

シリコン PNP 三重拡散形

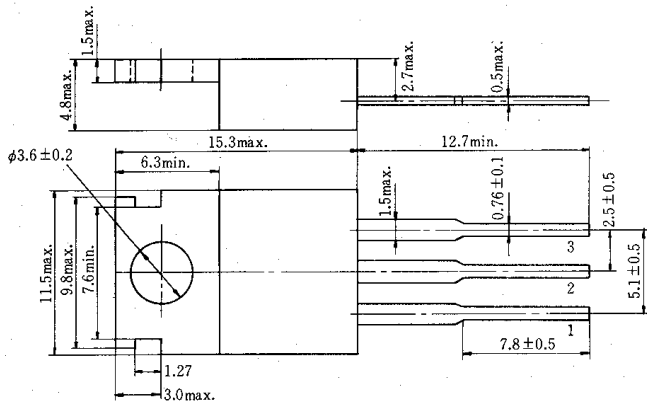
低周波電力増幅用

2SC1419とコンプリメンタリペア

SILICON PNP TRIPLE DIFFUSED

LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER

Complementary pair with 2SC1419



1. ベース: Base
  2. コレクタ: Collector  
(フランジ) (Flange)
  3. エミッタ: Emitter
- (Dimensions in mm)

(JEDEC TO-220AB)

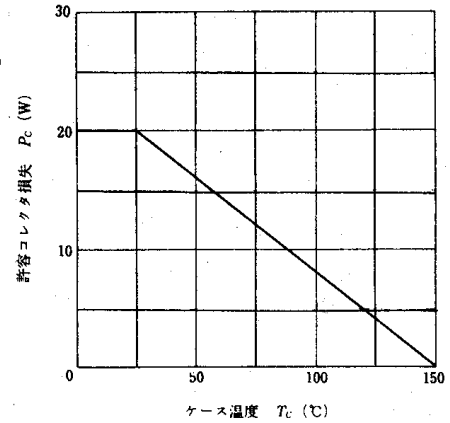
## ■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項	目	Symbol	2SA755	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$		-50	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$		-50	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$		-4	V
コレクタ電流	$I_C$		-2	A
許容コレクタ損失	$P_C^*$		20	W
接合部温度	$T_j$		150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$		-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

\*  $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値

\* Value at  $T_c=25^\circ\text{C}$

## 許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



## ■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項	目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$		$I_C=-5\text{mA}, I_E=0$	-50	-	-	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$		$I_C=-50\text{mA}, R_{BE}=\infty$	-50	-	-	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$		$I_E=-5\text{mA}, I_C=0$	-4	-	-	V
コレクタ遮断電流	$I_{CBO}$		$V_{CB}=-20\text{V}, I_E=0$	-	-	-100	$\mu\text{A}$
直流電流増幅率	$h_{FE}^*$		$V_{CE}=-4\text{V}, I_C=-1\text{A}$	35	-	200	
直流電流増幅率	$h_{FE}$		$V_{CE}=-4\text{V}, I_C=-0.1\text{A}$	35	-	-	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$		$I_C=-1.5\text{A}, I_B=-0.15\text{A}$	-	-	-1.3	V
ベース・エミッタ電圧	$V_{BE}$		$V_{CE}=-4\text{V}, I_C=-1\text{A}$	-	-0.9	-1.5	V
2次破壊電流	$I_M^{**}$		$V_{CE}=-30\text{V}, f=50\text{Hz (half wave)}$	-2.0	-	-	A
利得帯域幅積	$f_T$		$V_{CE}=-4\text{V}, I_C=-0.5\text{A}$	-	50	-	MHz

\* 2SA755は $h_{FE}$ の値により下記のように3区分し、現品に表示してあります。

\* The 2AS755 is grouped by  $h_{FE}$  as follows.

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
35~70	60~120	100~200

\*\* 2次破壊時における電流で定義される。

\*\*  $I_M$  is defined as the current at which second breakdown occurs.